

### ① 概要

インレンズ方式により、従来のFE-SEMでは困難であった高倍率（20万倍以上）の観察が可能となりました。また高倍率（80万倍程度まで）での明視野STEM像および暗視野STEMを同時に観察することも可能となりました。

### ② 主な仕様

- (1) 二次電子分解能：0.4nm (30kV)、1.6nm (1kV)
- (2) 加速電圧：0.5～30kV
- (3) 倍率：×60～2,000,000
- (4) 試料サイズ：平面 5.0mm×9.5mm×3.5mmH  
断面 2.0mm×6.0mm×5.0mmH

### ③ 特徴

- (1) 低加速電圧(0.5～5.0kV)下での高倍率(20万倍程度)観察が可能となり、反射電子像も同時に取得可能です。
- (2) ダメージの少ない30kVでの低加速STEM観察が可能です。
- (3) SEM/FIB共用フォルダを使用することにより、試料に触れることなく、FIB加工とSEM観察を短時間で繰り返し行うことができます。

### ④ 利用分野

- (1) 半導体：多層配線構造デバイス
- (2) 実装品：金属と樹脂材料を含む複合材料
- (3) 金属材料：微細組織、金属間化合物層
- (4) その他：触媒、微細粒子など



日立製 S-5500



Siチップデバイス構造の明視野STEM像